



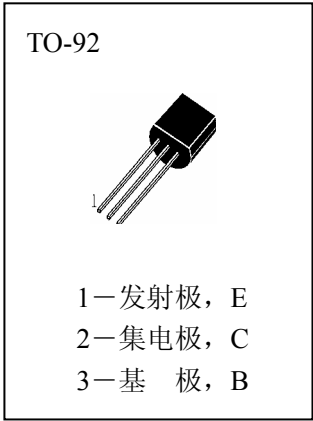
■ 主要用途

功率放大、开关应用。

■ 极限值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

T_{stg}	——贮存温度		$-55\sim 150^{\circ}\text{C}$
T_j	——结温		150°C
P_C	——集电极耗散功率		750mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压		-50V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压		-50V
V_{EB0}	——发射极—基极电压		-5V
I_C	——集电极电流		-2A

■ 外形图及引脚排列



■ 电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-50			V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-1.0	μA	$V_{\text{CB}}=-50\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1.0	μA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$, $I_C=0$
$H_{\text{FE}}(1)$	直流电流增益	70		240		$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$
$H_{\text{FE}}(2)$		40				$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-1.5\text{A}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-1\text{A}$, $I_B=-50\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	$I_C=-1\text{A}$, $I_B=-50\text{mA}$
f_T	特征频率		100		MHz	$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		40		pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$
t_{ON}	导通时间		0.1		μS	按特定测试电路
t_{STG}	贮存时间		1.0		μS	
t_F	下降时间		0.1		μS	

■ 分档及其标志

0	Y
70—140	120—240



汕头华汕电子器件有限公司

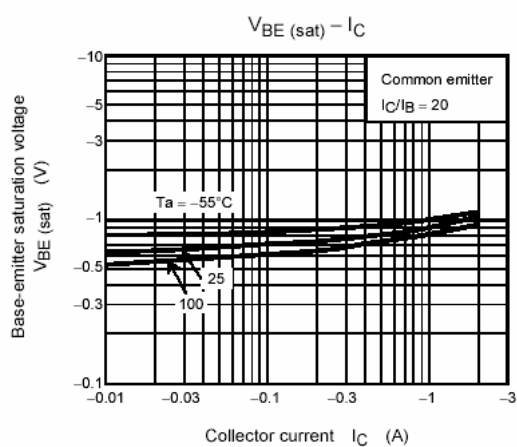
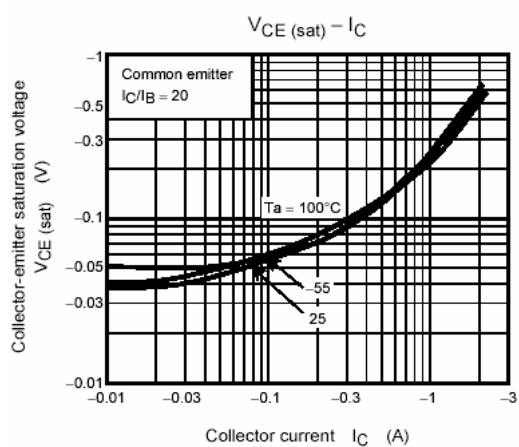
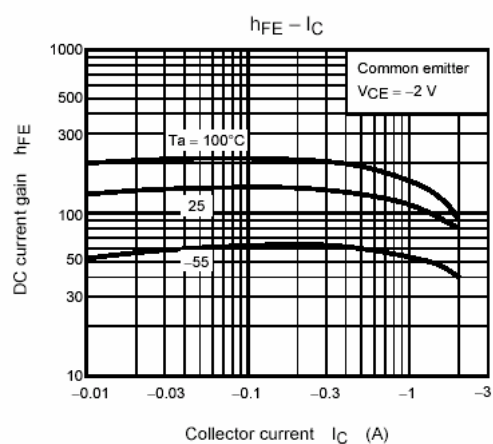
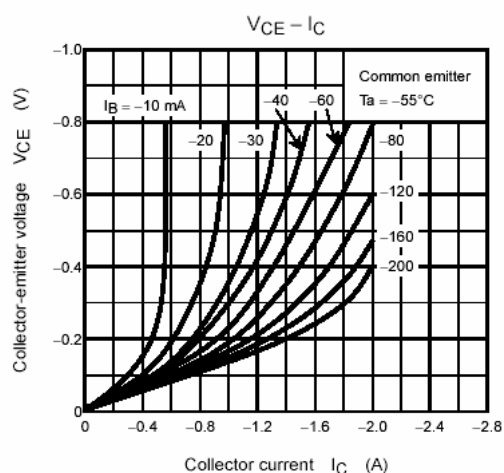
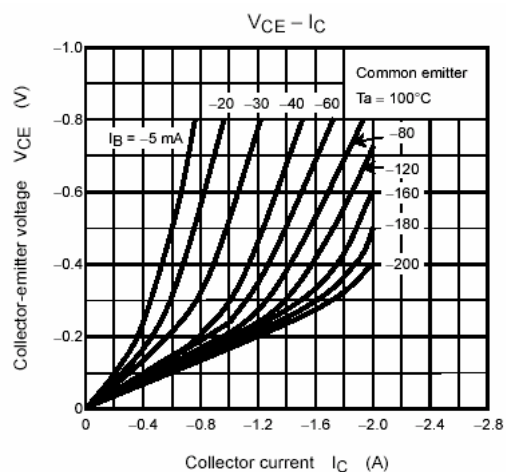
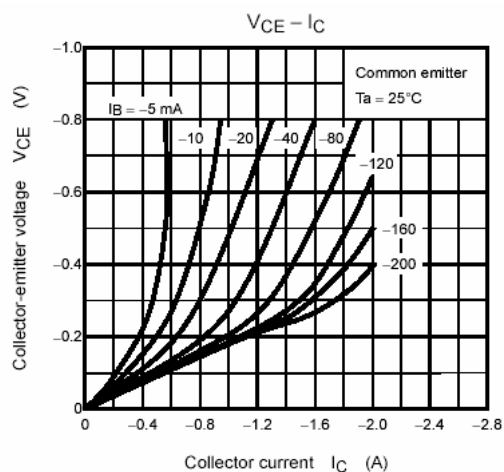
PNP SILICON TRANSISTOR

H1020S

对应国外型号

2SA1020

■ 特性曲线





汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1020S

对应国外型号

2SA1020

特性曲线

